(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2009-276648 (P2009-276648A)

(43) 公開日 平成21年11月26日(2009.11.26)

(51) Int.Cl. **GO2F** 1/1343 (2006.01)

1/1368

(2006, 01)

GO2F 1/1343 GO2F 1/1368

FI

テーマコード (参考) 2HO92

審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全 14 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日

GO2F

特願2008-129266 (P2008-129266) 平成20年5月16日 (2008.5.16) (71) 出願人 304053854

エプソンイメージングデバイス株式会社

長野県安曇野市豊科田沢6925

(74)代理人 100095728

弁理士 上柳 雅誉

(74)代理人 100107261

弁理士 須澤 修

(74)代理人 100127661

弁理士 宮坂 一彦

(72) 発明者 上條 公高

長野県安曇野市豊科田沢6925 エプソ

ンイメージングデバイス株式会社内

(72) 発明者 倉澤 隼人

長野県安曇野市豊科田沢6925 エプソ

ンイメージングデバイス株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】FFSモードの液晶表示装置において、正常な画像表示ができないディスクリネ

ーション発生部位が小さくなり、表示画質に優れた液晶 表示装置を提供すること。

【解決手段】本発明の液晶表示装置10Aは、液晶層を 挟持して対向配置された一対の基

板を有し、前記一対の基板の一方には層間膜上に複数の サブ画素領域が形成され、前記複

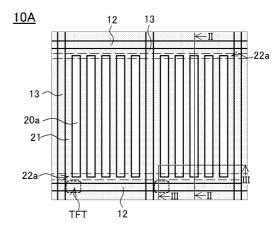
数のサブ画素領域のそれぞれには、複数のスリット状開口20aを有する上電極21と、

前記上電極20と絶縁層を介して前記層間膜側に形成された下電極と、前記液晶層側に形

成された配向膜と、を備えた液晶表示装置において、前記複数のスリット状開口20aの

長手方向の端部に対応する層間膜上には窪み22aが形成されていることを特徴とする。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

液晶層を挟持して対向配置された一対の基板を有し、

前記一対の基板の一方には層間膜上に複数のサブ画素領域が形成され、

前記複数のサブ画素領域のそれぞれには、複数のスリット状開口を有する上電極と、前記上電極と絶縁層を介して前記層間膜側に形成された下電極と、前記液晶層側に形成された配向膜と、を備えた液晶表示装置において、

前記複数のスリット状開口の長手方向の端部に対応する層間膜上には窪みが形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】

10) そ

前記複数のスリット状開口は屈曲部を備えており、前記スリット状開口及び上電極のそれぞれ屈曲部に対応する位置に一連の窪みが形成されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】

前記窪みはサブ画素毎に独立していることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置

【請求項4】

前記窪みは、行方向又は列方向において、隣接するサブ画素間に跨って形成されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項5】

20

30

前記窪みは、幅が3~6 μ mであり、深さが0.2~0.5 μ mであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項6】

前記窪みに対応する位置の前記一対の基板の他方には遮光部材が形成されていることを特徴とする請求項1~5の何れか1項に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、いわゆるFFS(Fringe Field Switching)モード等の横電界方式の液晶表示装置に関する。更に詳しくは、本発明は、液晶駆動用の電極の端部等に発生するディスクリネーションを抑制して表示品質を向上させた横電界方式の液晶表示装置に関する。

【背景技術】

[0002]

液晶表示装置としては、TN(Twisted Nematic)モード、VA(Vertical Alignment)モード、MVA(Multi-domain Vertical Alignment)モード等の縦電界方式のものが多く使用されているが、一方の基板にのみ電極を備えたFFSモードないしIPSモード等の横電界方式の液晶表示装置も知られている(下記特許文献1及び2参照)。この横電界方式の液晶表示装置のうち、FFSモードの液晶表示装置の動作原理を図9及び図10を用いて説明する。

[0003]

40

50

図9は従来例のFFSモードの液晶表示装置のカラーフィルタ基板を透視して表した1 画素分の模式平面図である。図10は図9のX-X線に沿った断面図である。

[0004]

このFFSモードの液晶表示装置70は、アレイ基板ARとカラーフィルタ基板CFとを備えている。アレイ基板ARは、第1の透明基板71の表面にそれぞれ平行に複数の走査線72及び共通配線73が設けられ、これら走査線72及び共通配線73に交差する方向に複数の信号線74が設けられている。そして、走査線72及び信号線74で区画された領域のそれぞれを覆うように共通配線73に接続されたITO(Indium Tin Oxide)やIZO(Indium Zinc Oxide)等の透明材料で形成された共通電極(下電極とも言われる)75が設けられている。この共通電極75の表面に絶縁膜76を介してストライプ状に

複数のスリット77が形成されたITO等の透明材料からなる画素電極78が設けられている。そして、この画素電極(上電極とも言われる)78及び複数のスリット77の表面は配向膜80により被覆されている。

[0005]

そして、走査線72と信号線74との交差位置の近傍にはスイッチング素子としてのTFTが形成されている。このTFTは、走査線72の表面に半導体層79が配置され、半導体層79の表面の一部を覆うように信号線74の一部が延在されてソース電極Sを構成し、半導体層79の下部の走査線部分がゲート電極Gを構成し、また、半導体層79の一部分と重畳する導電性層がドレイン電極Dを構成しており、このドレイン電極Dは画素電極78に接続されている。

[0006]

また、カラーフィルタ基板CFは、第二の透明基板82の表面にカラーフィルタ層83、オーバーコート層84及び配向膜85が設けられた構成を有している。そして、アレイ基板ARの画素電極78及び共通電極75とカラーフィルタ基板CFのカラーフィルタ層83とが互いに対向するようにアレイ基板AR及びカラーフィルタ基板CFを対向させる。次いで、アレイ基板ARとカラーフィルタ基板CFの間に液晶LCを封入すると共に、両基板AR、CFのそれぞれ外側に偏光板86及び87を配置することにより、FFSモードの液晶表示装置70が形成される。

[0007]

このFFSモードの液晶表示装置70は、画素電極78と共通電極75の間に電界を形成すると、図10に示したように、この電界は画素電極78の両側で共通電極75に向かう。そのため、スリット77に存在する液晶だけでなく画素電極78上に存在する液晶も駆動させることが可能である。従って、FFSモードの液晶表示装置70は広視野角かつ高コントラストであり、更に高透過率であるため明るい表示が可能となるという特徴を備えている。加えて、FFSモードの液晶表示装置70は、平面視で画素電極78と共通電極75との重複面積が大きいためにより大きな保持容量が副次的に生じ、別途補助容量線を設ける必要がなくなるという長所も存在する。

【 特 許 文 献 1 】 特 開 2 0 0 2 - 1 4 3 6 3 号 公 報

【特許文献2】特開2002-244158号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

ところで、FFSモードの液晶表示装置は、IPSモードの液晶表示装置も同様であるが、電極端で異常配向領域が発生し、この異常配向領域は、面押し試験などを行うと、発生領域が広がってリップル不良等が発生することが知られている。この異常配向領域の発生原理を図11A、図11B及び図12A~図12Eを用いて説明する。

[0009]

図11AはFFSモードの液晶表示パネルの上電極における1個のスリットの端部部分の電圧無印加時の模式拡大平面図であり、図11Bは電圧印加時の模式拡大平面図である。図12A~図12Eはそれぞれスリット状開口の境界の方向とラビング方向Yとのなす角度 の関係を示す図である。

[0 0 1 0]

この上電極91には、スリット状開口92が例えば斜め方向に傾いて形成されている。このスリット状開口92の底部には絶縁膜が存在しており、更にこの絶縁膜の下部には下電極が存在している。このスリット状開口92に対しラビング方向が図11AにおけるY方向であるとすると、電圧無印加時には液晶分子93aはラビング方向に配列している。この状態で上電極91と下電極との間に駆動電圧が印加されると、図11Bに示したように、上電極91と下電極との間に、スリット状開口92の境界に直角な方向に電界Eが生じ、この電界Eに対応して液晶分子93aが例えば所定角度 だけ水平回転する。

[0011]

10

20

30

40

ところが、電界 E の方向は、スリット状開口 9 2 の長辺 9 4 a 側及び 9 4 b 側ではそれ ぞれ同一方向であるが、スリット状開口 9 2 の端部 9 5 側では、スリット状開口 9 2 の一方の長辺側 9 4 a 側と他方側の長辺 9 4 b の間で方向が順次 1 8 0 °変化している。そのため、スリット状開口 9 2 の端部 9 5 側においては、上電極 9 1 と下電極との間に駆動電圧が印加された際、液晶分子の配向方向が右方向にも左方向にも回転し得る異常配向領域が存在する。

[0012]

すなわち、図12Aに示すように、配向膜のラビング方向をYとし、上電極91のスリット状開口92の長手方向をZとし、ZからYへ向かう鋭角部分の角度方向を正とすると、スリット状開口92の位置Aでは、スリット状開口の境界の方向とラビング方向Yとのなす鋭角部分の角度 は正 (>0°)となる。また、図12Bに示したスリット状開口92の位置Bでは、スリット状開口92の境界の方向とラビング方向Yとが平行となり、=0°となる。更に、図12Cに示したスリット状開口92の位置Cでは、スリット状開口92の位置Cからラビング方向Yへ向かう鋭角部分の角度 は、方向が図12Aに示した位置Aの場合とは逆方向になるので、 は負 (<0°)となる。同様に、図12Dに示したスリット状開口92の位置Dでは =±90°となり、更に、図12Eに示したスリット状開口92の位置Eでは、スリット状開口92の境界の方向とラビング方向Yとの間の鋭角部分の角度 は、図12Aに示した位置Aと同じ方向であるので、正 (>0°)となる。

[0013]

そのため、スリット状開口92の端部95側においては、上電極91と下電極との間に駆動電圧が印加された際、図12Bに示した位置Bと図12Dに示した位置Dとの間では、液晶分子の配向方向が右方向にも左方向にも回転し得る異常配向領域となる。このようなスリット状開口92の端部95側の異常配向領域はリバースツイストドメインと称されている。従来のFFSモードの液晶表示装置では、異常配向領域は正常な画像表示ができないディスクリネーション発生部となるため、このディスクリネーション発生部を遮光部材で遮光するようにしている。このように、ディスクリネーション発生部を遮光部材で遮光すると、開口率の損失が生じる。

[0014]

一方、このようなリバースツイストドメインが広がることを抑制するため、スリット端部の角度を変え、ラビング方向とのなす角度を高めることが提案されているが、スリット端部の角度がラビング方向に対して大きな角度となるようにすると透過率が低下してしまう不都合が発生する。また、スリットの形状を屈曲部を有するV字形ないし「く」字形とした場合には、屈曲部においてもリバースツイストドメインが発生し易い。このような異常な配向領域は視覚的なムラとなり、表示品位を低下させる。

[0015]

本発明は、上記問題点に鑑み、FFSモードの液晶表示装置において、正常な画像表示ができないディスクリネーション発生部位が小さくなるようにしてり、表示画質に優れた液晶表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0016]

上記目的を達成するため、本発明の液晶表示装置は、液晶層を挟持して対向配置された一対の基板を有し、前記一対の基板の一方には層間膜上に複数のサブ画素領域が形成され、前記複数のサブ画素領域のそれぞれには、複数のスリット状開口を有する上電極と、前記上電極と絶縁層を介して前記層間膜側に形成された下電極と、前記液晶層側に形成された配向膜と、を備えた液晶表示装置において、前記複数のスリット状開口の長手方向の端部に対応する層間膜上には窪みが形成されていることを特徴とする。

[0017]

本発明の液晶表示装置は、液晶層を挟持して対向配置された一対の基板を有し、前記一対の基板の一方には層間膜上に複数のサブ画素領域が形成され、前記複数のサブ画素領域

10

20

30

40

のそれぞれには、複数のスリット状開口を有する上電極と、前記上電極と絶縁層を介して前記層間膜側に形成された下電極と、前記液晶層側に形成された配向膜と、を備えている。係る構成によって本発明の液晶表示装置は FFSモードで作動するものとなる。

[0018]

そして、本発明の液晶表示装置においては、前記複数のスリット状開口の長手方向の端部に対応する層間膜上には窪みが形成されている。このようにスリット状開口の長手方向の端部に対応する層間膜上に窪みが形成されているものとすると、液晶の異常配向領域が拡大することが抑制される。そのため、本発明の液晶表示装置によれば、ディスクリネーションの発生領域が狭くなり、表示画質が良好なFFSモードの液晶表示装置が得られる。加えて、本発明の液晶表示装置によれば、特にスリット端部の角度を変えてラビング方向とのなす角度を高めるようなことはしていないため、従来例のように透過率が低くなるようなことがなく、明るい表示の液晶表示装置となる。なお、本発明の液晶表示装置においては、窪みの形状は、断面がV字状であっても、U字状であっても、更には、口状であってもよい。

[0019]

また、本発明の液晶表示装置においては、前記複数のスリット状開口は屈曲部を備えており、前記スリット状開口及び上電極のそれぞれ屈曲部に対応する位置に一連の窪みが形成されているものとすることができる。

[0020]

FFSモード等、横方向電界モードの液晶表示装置においては、視野角特性向上と色つき低減を目的として、複数のスリット状開口を「く」字状、V字状等、屈曲部を有するものとすることが行われている。このスリット状開口及び上電極のそれぞれ屈曲部に対応する位置では、互いに異なる液晶配向ドメインの境界が生成するため、ディスクリネーション発生領域となる。このスリット状開口及び上電極のそれぞれ屈曲部に対応する位置に一連の窪みを形成すると、液晶の異常配向領域が窪み内及びその近傍に集中するため、液晶の異常配向領域が拡大することが抑制される。そのため、本発明の液晶表示装置によれば、スリット状開口及び上電極のそれぞれ屈曲部に対応する位置においてもディスクリネーションの発生領域が狭くなるので、視野角特性向上効果及び色つき低減効果と相まって、より表示画質が良好なFFSモードの液晶表示装置が得られる。

[0021]

また、本発明の液晶表示装置においては、前記窪みはサブ画素毎に独立しているものと することができる。

[0022]

窪みがサブ画素毎に独立しているとサブ画素間のディスクリネーション領域が連結して大きなディスクリネーション領域となることが少なくなる。そのため、本発明の液晶表示装置によれば、より表示画質が良好なFFSモードの液晶表示装置が得られる。

[0023]

また、本発明の液晶表示装置においては、前記窪みは、行方向又は列方向において、隣接するサブ画素間に跨って形成されているものとすることができる。

[0024]

通常、層間膜はフォトレジスト材料から形成される。本発明の液晶表示装置によれば、 窪みが隣接するサブ画素間に跨って形成されているので、窪み形成用の露光マスクの構成 を簡単なものとすることができ、製造が容易となる。

[0 0 2 5]

また、本発明の液晶表示装置においては、前記窪みは、幅が 3 ~ 6 μ m であり、深さが 0 . 2 ~ 0 . 5 μ m であることが好ましい。

[0026]

窪みの幅が 3 μ m 未満であると窪みを設けることの効果が現れず、また、窪みの幅が 6 μ m を超えると、ディスクリネーション領域が広がるようになるので、本発明の効果が現れなくなる。更に、窪みの深さが 0 . 2 μ m 未満であると窪みを設けることの効果が現れ

10

20

30

40

ず、また、窪みの深さが 0.5μ mを超えると至って液晶の配向が乱れるようになるので、表示画質の低下に繋がる。より好ましい窪みの幅は $4.5\sim5\mu$ mであり、また、より好ましい窪みの深さは $0.35\sim0.4\mu$ mである。

[0027]

また、本発明の液晶表示装置においては、前記窪みに対応する位置の前記一対の基板の他方には遮光部材が形成されていることが好ましい。

[0028]

本発明における窪みは、ディスクリネーション発生領域が生じているが、このディスクリネーション発生領域は従来例のものに比すると狭くなっている。そのため、本発明の液晶表示装置によれば、遮光しなければならない領域は従来例のものよりも狭くなるので、表示画質が良好で明るい表示の液晶表示装置が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0029]

以下、図面を参照して本発明の最良の実施形態を説明する。但し、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための液晶表示装置を例示するものであって、本発明をこの液晶表示装置に特定することを意図するものではなく特許請求の範囲に含まれるその他の実施形態のものにも等しく適応し得るものである。また、この明細書における説明のために用いられた各図面においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならせて表示しており、必ずしも実際の寸法に比例して表示されているものではない。

[0030]

図1は第1の実施形態に係る液晶表示装置のカラーフィルタ基板を透視して表した1画素分の概略平面図である。図2は図1のII-II線に沿った断面図である。図3は図1のII-II線に沿った断面図である。図3は図1のII-II線に沿った断面図である。図4Aは露光前の層間膜の状態を示す断面図であり、図4Cは現像後の層間膜の状態を示す図である。図5は第2の実施形態に係る液晶表示装置のカラーフィルタ基板を透視して表した1画素分の概略平面図である。図6は図5のVI-VI線に沿った断面図である。図7は略平面図である。図8は図7のVIII-VIII線に沿った断面図である。

[0031]

「第1の実施形態]

第1の実施形態の液晶表示装置を図1~図4を用いて説明する。この第1の実施形態の液晶表示装置10Aは、アレイ基板ARと、カラーフィルタ基板CFとを備えている。アレイ基板ARは、ガラス基板等からなる第1の透明基板11の表示領域の表面にマトリクス状に複数の走査線12及び信号線13が互いにゲート絶縁膜14で絶縁された状態で交差するように形成されており、更に、表示領域の周縁部に共通配線(図示省略)が形成されている。これらの走査線12及び信号線13で囲まれたそれぞれの領域がサブ画素を形成する。また、第1の透明基板11には画素毎にスイッチング素子として例えばTFTが形成されており、このTFTを含む第1の透明基板11の表面全体に亘って例えば窒化ケイ素層ないし酸化ケイ素層からなるパッシベーション膜15で被覆されている。

[0032]

そして、パッシベーション膜15の表面にはフォトレジスト材料からなる層間膜16が形成されており、この層間膜16及びパッシベーション膜15にはTFTのドレイン電極Dに対応する位置にコンタクトホール17が形成されているとともに、信号線13に沿って窪み22aが形成されている。なお、この窪み22aの構成については後述する。そして、層間膜16の表面には、それぞれの画素領域にITOないしIZO等の透明導電性材料からなる下電極18が形成されており、この下電極18はコンタクトホール17を経てTFTのドレイン電極Dに電気的に接続されている。従って、第1の実施形態の液晶表示装置10Aでは、下電極18は画素電極として機能する。

[0033]

10

20

30

10

20

30

40

50

更に、下電極18が形成された第1の透明基板11の表面全体に亘って窒化ケイ素層ないし酸化ケイ素層からなる絶縁膜19が形成されている。この絶縁膜19の表面には、それぞれの画素に互いに平行に伸びる複数のスリット状開口20aを有する上電極21が形成されている。上電極21はITOないしIZO等の透明導電性材料で形成されており、表示領域の周縁部で図示しない共通配線に電気的に接続されている。また、上電極21の表面及びスリット状開口20aの内面は配向膜23が被覆されている。従って、第1の実施形態の液晶表示装置10Aでは、上電極21は共通電極として機能する。なお、下電極18及び上電極21のうち、どちらをTFTのドレイン電極Dと接続するか及びどちらを共通配線と接続するかは任意である。

[0034]

また、カラーフィルタ基板 C F は、図 2 及び図 3 に示したように、ガラス基板等の第 2 の透明基板 2 5 の表面に、アレイ基板 A R の走査線 1 2 、信号線 1 3 、コンタクトホール 1 7 及びTFTに対応する位置を被覆するように遮光膜 2 6 が形成されている。更に、遮光膜 2 6 で囲まれた第 2 の透明基板 2 5 の表面には、所定の色のカラーフィルタ層 2 7 が形成されている。また、遮光膜 2 6 及びカラーフィルタ層 2 7 の表面を被覆するようにオーバーコート層 2 8 が形成されている。そして、オーバーコート層 2 8 の表面には配向膜 2 9 が形成されている。このカラーフィルタ基板 C F の配向膜 2 9 とアレイ基板 A R の配向膜 2 3 のラビング方向は、平面視で同一方向であるが、上電極 2 1 に形成されるスリット 1 7 に対して例えば 5 ° ~ 1 0 °程度傾いているようになされる。

[0035]

[0036]

そして、アレイ基板ARの下電極18及び上電極21とカラーフィルタ基板CFのカラーフィルタ層26とが互いに対向するように、アレイ基板ARとカラーフィルタ基板CFが対向され、その間に液晶30が封入されている。更に、アレイ基板ARの外側に第1の偏光板31及びバックライト装置(図示省略)が配置され、カラーフィルタ基板CFの外側に第2の偏光板32が配置されて第1の実施形態の液晶表示装置10Aが完成される。

ここで、この第1の実施形態のFFSモードの液晶表示装置10Aのアレイ基板ARの製造方法を、図1~図3と共に図4A~図4Cを参照して説明する。まず、ガラス基板等の第1の透明基板11の表示領域に複数の走査線12を互いに平行になるように形成し、次いで、この表面全体に窒化ケイ素層ないし酸化ケイ素層からなるゲート絶縁膜14を被覆する。その後、TFT形成領域に例えばアモルファスシリコン(a-Si)層を形成する。このa-Si層が形成されている位置の走査線12の領域がTFTのゲート電極Gになる。

[0037]

次いで、表示領域において走査線12に交差するようにソース電極Sを含む信号線13を形成し、TFT形成領域にドレイン電極Dを形成すると共に、表示領域の周囲に共通配線(図示せず)等を形成する。その後、上記工程で得られた第1の透明基板11の表面全体にパッシベーション膜15を被覆する。このパッシベーション膜15としては、窒化ケイ素層ないし酸化ケイ素層からなるものを使用することができるが、絶縁性の観点からは窒化ケイ素層の方が望ましい。その後、パッシベーション膜15の表面全体に例えばフォトレジスト材料からなる層間膜16を積層する(図4A参照)。ここまでの工程は、従来のFFSモードの液晶表示装置の製造工程と同様であるので、その詳細な説明は省略してある。

[0038]

次いで、多階調マスク、例えばハーフトーンマスク35を用いて露光及び現像処理を行う(図4B参照)。多階調マスクは、基板内で異なるフォトレジスト膜厚を残す目的で使用されているものであり、ハーフトーンマスク及びグレイトーンマスクが知られている。ハーフトーンマスク35は、バイナリーマスク36の光透過部そのものと同様の構成の部分が全光量透過部37となり、このバイナリーマスク36の光透過部に露光光の一部を吸収する光吸収部材38が設けられた部分が中間光量透過部39となる。そして、中間光量

透過部39の透過率は、光吸収部材38の吸光度を変えることによって種々の数値をとることができる。

[0039]

中間光量透過部39の吸光度が20%未満であると露光機の光源の輝度の変動を考慮すると実質的に全光量透過部37と変わらなくなる。また、中間光量透過部39の吸光度が60%を超えると透過する光量が減少しすぎて薄いフォトレジスト層であっても完全露光に時間がかかるようになる。そのため、最適な中間光量透過部39の吸光度は20%~60%である。なお、多階調マスクとしてグレイトーンマスクも使用し得る。グレイトーンマスクは、前記中間光量透過部39が解像限界以下のスリットパターンが複数個形成された部分からなるものであり、このスリットの幅や所定幅当たりのスリットの個数を変えることにより中間光量透過部39の光透過率を変えることができる。

[0040]

そして、第1の実施形態では、層間膜16の窪み22aは多階調マスクの中間光量を得る部分で、コンタクトホール17の形成位置を含む表示領域の周縁部の厚いフォトレジスト層は多階調マスクの全光量を得る部分で、それぞれ一括して露光する。そうすると、層間膜16の窪み22aのフォトレジスト層もコンタクトホール17及び表示領域の周縁部の厚いフォトレジスト層も、多階調マスクの中間光量を得る部分の光透過率を適宜に調整することにより、最適露光量で一括して露光させることができるようになる。その後に現像処理を行うことにより、層間膜16に窪み22aを形成すると共にコンタクトホール17の形成部分及び表示領域の周縁部のフォトレジスト層を除去することができる(図4C参照)。

[0041]

次いで、コンタクトホール17を形成する部分のパッシベーション膜15をエッチング法によって除去する。このコンタクトホール17の形成には、乾式エッチング法の1種であるプラズマエッチング法を採用し得る。更に、スパッタ法等によりITOないしIZOからなる下側の透明導電層を積層する。このとき、形成された透明導電層は、層間膜16の窪み22aの内部に対しても一定の厚さで積層され、また、ドレイン電極Dと電気的に接続される。この後、フォトリソグラフィー法及びエッチング法によって、表示領域のサブ画素毎に下電極18を所定のパターンに形成する。このとき、下電極18の端部が窪み22a内に位置するように形成すると、ディスクリネーション生成領域が広がり難くなるので、好ましい。

[0042]

更に、下電極18が形成された透明基板11の表面全体に窒化ケイ素層ないし酸化ケイ素層からなる絶縁膜19を所定の厚さ、例えば2000 ~4000 に形成する。絶縁膜19は、層間膜16や下電極18の表面を荒らさないようにするため、ゲート絶縁膜14やパッシベーション膜15の形成条件よりも穏やかなプラズマCVD条件、いわゆる低温成膜条件で形成する。

[0043]

更に、スパッタ法等によりITOないしIZOからなる上側の透明導電層を絶縁膜19の表面全体を被覆するように積層する。このとき、透明導電層と共通配線とは表示領域の周辺部のコンタクトホール(図示せず)で電気的に接続された状態となる。その後、フォトリソグラフィー法及びエッチング法によって、表示領域においては上電極21のスリット状開口20aに対応する位置の絶縁膜19の表面が露出するように、表示領域の周辺部では所定のパターンとなるように、透明導電層をエッチングする。また、上電極21は、表示領域の全体を被覆しており、表示領域の周縁部で共通配線と電気的に接続された状態となる。この後、上電極21側の表面全体に配向膜23を設けることにより第1の実施形態の液晶表示装置10Aのアレイ基板ARが完成される。

[0044]

このようにスリット状開口 2 0 a の長手方向の端部に対応する層間膜 1 6 上に窪み 2 2 a を形成すると、液晶 3 0 の異常配向領域が窪み 2 2 a 内及びその近傍に集中するため、

10

20

30

40

10

20

30

40

50

液晶の異常配向領域が拡大することが抑制される。そのため、第1の実施形態の液晶表示装置10Aによれば、ディスクリネーションの発生領域が狭くなり、表示画質が良好なFFSモードの液晶表示装置10Aが得られる。なお、第1の実施形態の液晶表示装置10Aにおいては、窪み22aの断面塊状がV字状のものを示したが、これに限らず、断面塊状がU字状であっても、更には口状であってもよい。

[0045]

なお、第1の実施形態では、上電極21に形成されるスリット状開口20aが信号線13に沿って平行に形成された例を示したが、走査線12に沿って平行に形成されているようにしてもよく、更には走査線12及び信号線13に対して傾いた方向となるようにしてもよい。

[0046]

「第2の実施形態]

次に、第2の実施形態の液晶表示装置10Bを図5及び図6を用いて説明する。なお、図5及び図6においては、図1~図4に示した第1の実施形態の液晶表示装置10Aと同一の構成部分には同一の参照符号を付与してその詳細な説明は省略する。

[0047]

第2の実施形態の液晶表示装置10Bが第1の実施形態の液晶表示装置10Aと構成が相違する点は、

(1)上電極21に形成されるスリット状開口20bが屈曲部20b'を有する「く」字状とされている点、及び、

(2)層間膜16の表面に、スリット状開口20bの長手方向の端部に窪み22bを形成するだけでなく、スリット状開口20bの屈曲部20b′に対応する位置及びスリット状開口20bを有する上電極21の前記屈曲部20b′に対応する位置に一連の別の窪み2 2b′を形成した点、

である。

[0048]

すなわち、第2の実施形態の液晶表示装置10Bは、従来例のFFSモードの液晶表示装置の場合と同様に、複数のスリット状開口20bとして屈曲部20b'を有する「く」字状とすることによって、視野角特性向上と色つき低減という効果が奏される。また、第2の実施形態の液晶表示装置10Bでは、第1の実施形態の液晶表示装置10Aの場合と同様に、スリット状開口20bの長手方向の端部に対応する層間膜16上に窪み22bを形成したので、液晶30の異常配向領域が窪み22b内及びその近傍に集中するため、液晶30の異常配向領域が拡大することが抑制される。

[0049]

また、第2の実施形態の液晶表示装置10Bでは、スリット状開口20bの屈曲部20b'に対応する位置及びスリット状開口20bを有する上電極21の前記屈曲部20b'に対応する位置においても互いに異なる液晶配向ドメインの境界が生成するため、ディスクリネーション発生領域となる。そこで、第2の実施形態の液晶表示装置10Bにおいては、このスリット状開口20bの屈曲部20b'に対応する位置及びスリット状開口20bを有する上電極21の前記屈曲部20b'に対応する位置に一連の別の窪み22b'を形成している。それによって、スリット状開口20bの屈曲部20b'に対応する位置及びスリット状開口20bの屈曲部20b'に対応する位置及びスリット状開口20bを有する上電極21の前記屈曲部20b'に対応する位置における液晶の異常配向領域を窪み22b'内及びその近傍に集中させることができる。そのため、第2の実施形態の液晶表示装置10Bによれば、スリット状開口20bの屈曲部20b'に対応する位置及びスリット状開口20bを有する上電極21の前記屈曲部20b'に対応する位置においてもディスクリネーションの発生領域が狭くなるので、視野角特性向上効果及び色つき低減効果と相まって、より表示画質が良好なFFSモードの液晶表示装置10Bが得られる。

[0050]

なお、第2の実施形態では、上電極21に形成されるスリット状開口20bが信号線1

3に沿って「く」字状となるように形成された例を形成したが、走査線12に沿って「く」字状となるように形成されているようにしてもよい。また、窪み22bないし22b'は、サブ画素毎に独立して形成されていてもよいが、隣接するサブ画素間に跨って形成されていてもよい。層間膜16はフォトレジスト材料から形成されるので、窪み22bないし22b'が隣接するサブ画素間に跨って形成されていると、窪み22bないし22b'の形成用の露光マスクの構成を簡単なものとすることができるので、製造が容易となる。

[0051]

[第3の実施形態]

次に、第3の実施形態の液晶表示装置10Cを図7及び図8を用いて説明する。なお、図7~図8においては、図5及び図6に示した第2の実施形態の液晶表示装置10Bと同一の構成部分には同一の参照符号を付与してその詳細な説明は省略する。

[0052]

第3の実施形態の液晶表示装置10Cが第2の実施形態の液晶表示装置10Bと構成が相違する点は、上電極21に形成されるスリット状開口20cとして、列方向の中央部のスリット状開口20cのみが屈曲部20c′を有する「く」字状とされており、他のスリット状開口20cは「く」字状のスリット状開口20cの延在方向に沿って直線状に平行に形成されている点、である。

[0053]

第3の実施形態の液晶表示装置10℃では、スリット状開口20cの屈曲部に20c′対応する位置及びこの屈曲部20c′から双方向に延在されているスリット状開口20cの中間位置においても互いに異なる液晶配向ドメインの境界が生成されるため、ディスクリネーション発生領域となる。そこで、第3の実施形態の液晶表示装置10℃においては、このスリット状開口20cの屈曲部20c′に対応する位置及びスリット状開口20bを有する上電極21の前記屈曲部20b′に対応する位置に一連の別の窪み22c′を形成している。それによって、スリット状開口20cの屈曲部20c′に対応する位置及びスリット状開口20bを有する上電極21の前記屈曲部20b′に対応する位置における液晶の異常配向領域を窪み22c′内及びその近傍に集中させることができる。そのため、第3の実施形態の液晶表示装置10℃によれば、第2の実施形態の液晶表示装置10mよれば、第2の実施形態の液晶表示装置10mよれば、第2の実施形態の液晶表示装置10mが得られる。

[0054]

なお、第3の実施形態では、上電極21に形成されるスリット状開口20cを走査線1 2に沿って延在するように形成した例を示したが、信号線に沿って延在するように形成し てもよい。

【図面の簡単な説明】

[0055]

【 図 1 】 第 1 の実施形態に係る液晶表示装置のカラーフィルタ基板を透視して表した 1 画素分の概略平面図である。

【図2】図1の11-11線に沿った断面図である。

【図3】図1の111-111線に沿った断面図である。

【図4】図4Aは露光前の層間膜の状態を示す断面図であり、図4Bは露光中の層間膜の状態を示す断面図であり、図4Cは現像後の層間膜の状態を示す図である。

【図5】第2の実施形態に係る液晶表示装置のカラーフィルタ基板を透視して表した1画素分の概略平面図である。

【図6】図5のVI-VI線に沿った断面図である。

【 図 7 】 第 3 の実施形態に係る液晶表示装置のカラーフィルタ基板を透視して表した 1 画素分の概略平面図である。

【図8】図7のVIII-VIII線に沿った断面図である。

【図9】従来例のFFSモードの液晶表示装置のカラーフィルタ基板を透視して表した1 画素分の模式平面図である。 10

20

30

40

【図10】図9のX-X線に沿った断面図である。

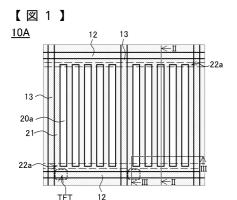
【図11】図11AはFFSモードの液晶表示パネルの上電極における1個のスリットの端部部分の電圧無印加時の模式拡大平面図であり、図11Bは電圧印加時の模式拡大平面図である。

【図 1 2 】図 1 2 A ~ 図 1 2 E はそれぞれスリット状開口の境界の方向とラビング方向 Y とのなす角度 の関係を示す図である。

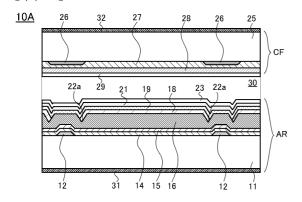
【符号の説明】

[0056]

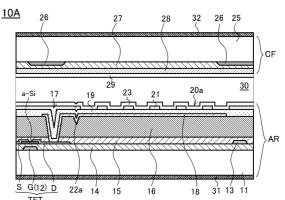
1 0 A ~ 1 0 C : 液晶表示装置 1 1 : 第 1 の透明基板 1 2 : 走査線 1 3 : 信号線 1 4 : ゲート絶縁膜 1 5 : パッシベーション膜 1 6 : 層間膜 1 7 : コンタクトホール 1 8 : 下電極 1 9 : 絶縁膜 2 0 a ~ 2 0 c : スリット状開口 2 0 b '、2 0 c ' : 屈曲部 2 1 : 上電極 2 2 a ~ 2 2 c、2 2 b '、2 2 c ' : 窪み 2 3 : 配向膜 2 5 : 第 2 の透明基板 2 6 : 遮光膜 2 7 : カラーフィルタ層 2 8 : オーバーコート層 2 9 : 配向膜 3 0 : 液晶 3 5 : ハーフトーンマスク 3 6 : バイナリーマスク 3 7 : 全光量透過部 3 8 : 光吸収部材 3 9 : 中間光量透過部



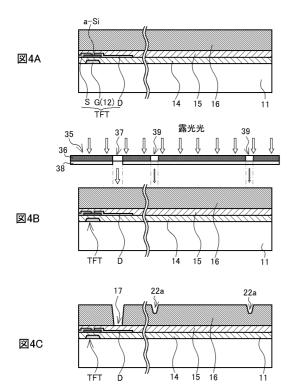
【図2】



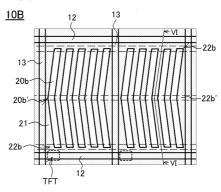
【図3】



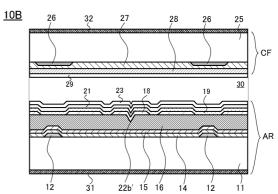
【図4】

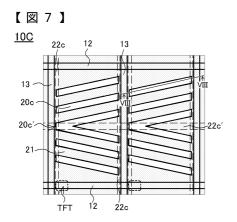


【図5】

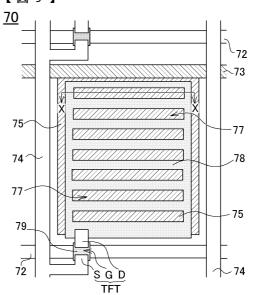


【図6】

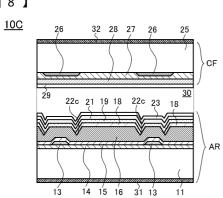


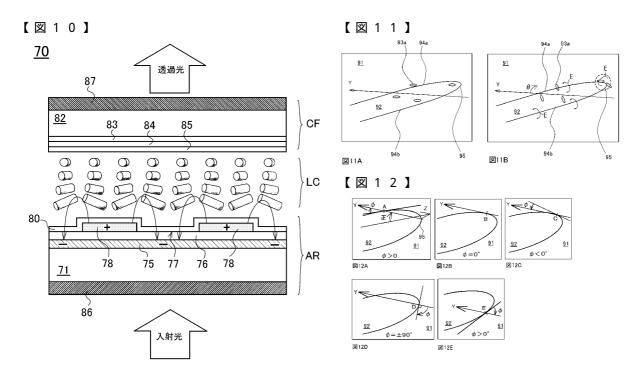


【図9】



【図8】





フロントページの続き

(72)発明者 中原 多惠

長野県安曇野市豊科田沢6925 エプソンイメージングデバイス株式会社内 Fターム(参考) 2H092 GA14 GA16 GA17 HA04 JA24 JB05 JB56 KB14 KB25 MA12 NA04 PA02 QA06



| 专利名称(译) | 液晶表示装置 | | |
|----------------|---|---------|------------|
| 公开(公告)号 | <u>JP2009276648A</u> | 公开(公告)日 | 2009-11-26 |
| 申请号 | JP2008129266 | 申请日 | 2008-05-16 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 爱普生映像元器件有限公司 | | |
| 申请(专利权)人(译) | 爱普生影像设备公司 | | |
| [标]发明人 | 上條公高 倉澤隼人 中原多惠 | | |
| 发明人 | 上條 公高 倉澤 隼人 中原 多惠 | | |
| IPC分类号 | G02F1/1343 G02F1/1368 | | |
| FI分类号 | G02F1/1343 G02F1/1368 | | |
| F-TERM分类号 | 2H092/GA14 2H092/GA16 2H092/GA17 2H092/HA04 2H092/JA24 2H092/JB05 2H092/JB56 2H092 /KB14 2H092/KB25 2H092/MA12 2H092/NA04 2H092/PA02 2H092/QA06 2H192/AA24 2H192/BB12 2H192/BB42 2H192/BB53 2H192/BB73 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192 /EA68 2H192/HA44 2H192/JA33 | | |
| 代理人(译) | 须泽 修 宫坂和彦 | | |
| 外部链接 | <u>Espacenet</u> | | |
| | | | |

摘要(译)

要解决的问题:提供FFS模式的液晶显示装置, 提供一种具有减小的显示区域和优异的显示图像质量的液晶显示装置。 解决方案:本发明的液晶显示装置10A具有一对彼此相对布置的组,其间插入有液晶层 在一对基板中的一个基板上的层间膜上形成多个子像素区域, 在多个子像素区域中的每一个中,上电极21具有多个狭缝形开口20a,下层电极形成在层间膜侧,上电极20和绝缘层介于其间,下电极形成在液晶层侧 和形成的取向膜,其中多个狭缝形开口20a 并且,在中间膜上形成凹陷22a,该凹陷22a对应于纵向方向上的端部。 点域1

